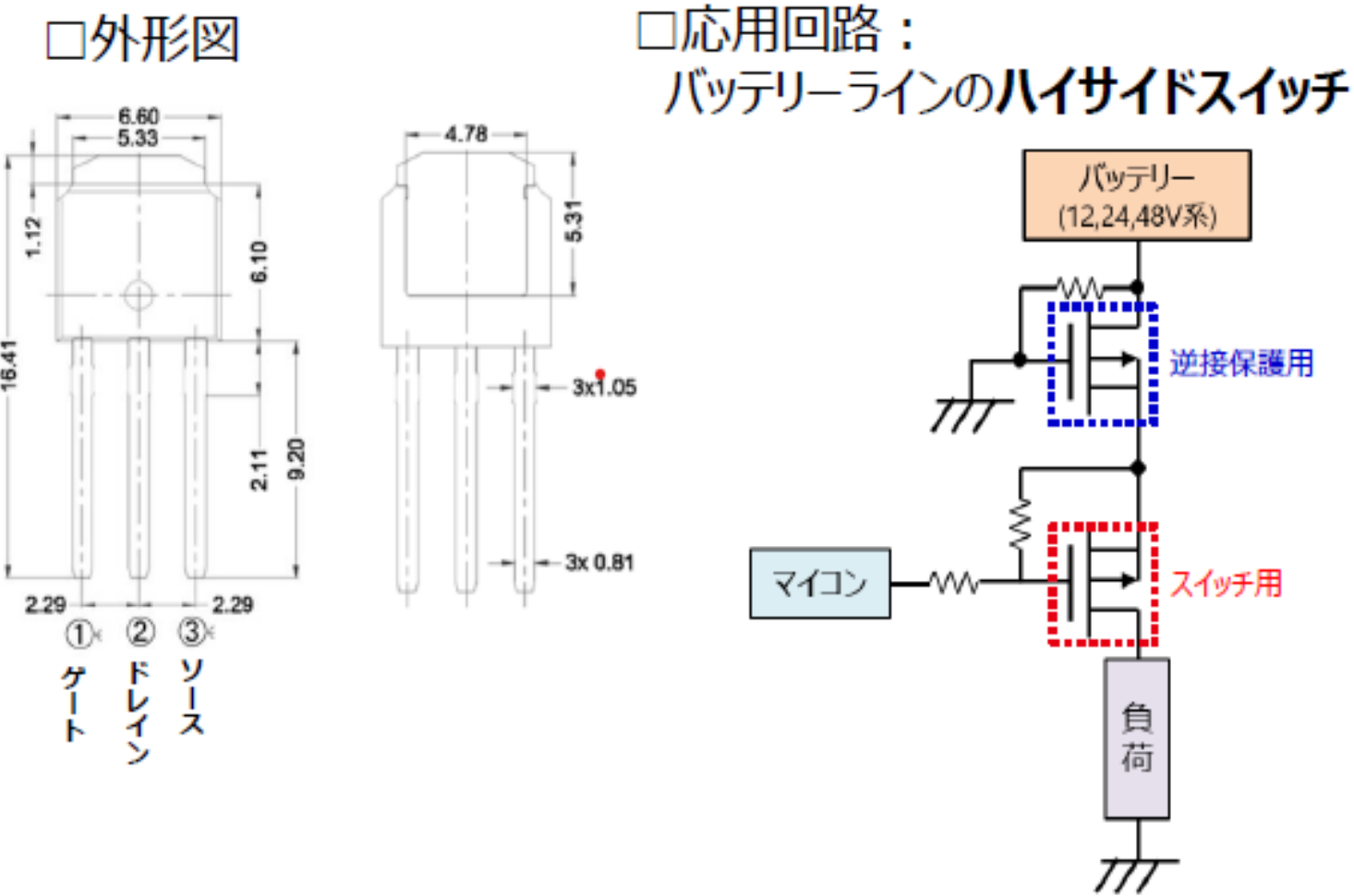


INJ0D10AH2 製品紹介



項目	詳細
主題	大電流・高負荷用途に対応するTO-251 Pch MOSFET 48Vバッテリーのハイサイドスイッチにも適したINJ0D10AH2
製品概要	INJ0D10AH2は、高許容損失パッケージにPチャネルMOSFETを搭載した、大電流・高負荷用途向けのMOSFETです。TO-251パッケージのため基板への挿入実装が容易で、修理・交換にも適しています。ヒートシンクや放熱板との組み合わせにより、高い放熱性と柔軟な熱設計が可能です。
主な特長	・許容損失：25W（Tc=25℃） ・ドレイン電流：-17A（Tc=25℃） ・低RDS(ON)：50mΩ ・3ピン挿入実装タイプ ・ヒートシンク／放熱板との組み合わせによる熱設計が可能
主な用途	バッテリーラインのハイサイドスイッチ、産業機器・制御盤、DCモーター制御など。高い許容損失を活かし、モーター・ポンプ・ソレノイドなど比較的負荷の大きい機器への使用も想定されています。
ターゲットアプリケーション	・LED駆動用：LED照明、車載用ランプ ・モータ駆動用：プリンタ、家電製品等のファンモータ、電動工具 ・Li-Ion充電制御用：バッテリー充電器 ・DC-DCコンバーター：家電製品、産業機器 ・ロードスイッチ：家電製品、産業機器
車載関連	大電流MOSFETで車載実績あり。
TO-251生産継続	TO-251パッケージは今後も生産継続予定。組み立てメーカーからも生産を終了する予定がないことを確認済み。
代替提案	同等クラスのTO-251製品にはEOL品があり、TO-251パッケージの代替品を検討しているお客様への提案候補となります。
お問い合わせについて	TO-251パッケージのMOSFETをお探しの方、異なる電圧・電流等の仕様をご検討の方もお気軽にお問い合わせください。



主要製品仕様						
製品名	VDSS	ID (Tc=25℃)	PD (Tc=25℃)	RDS(ON)	パッケージ	
INJ0D10AH2	-60 V	-17 A	25 W	50 mΩ	TO-251	